

บทที่ 4

ผลการวิจัย

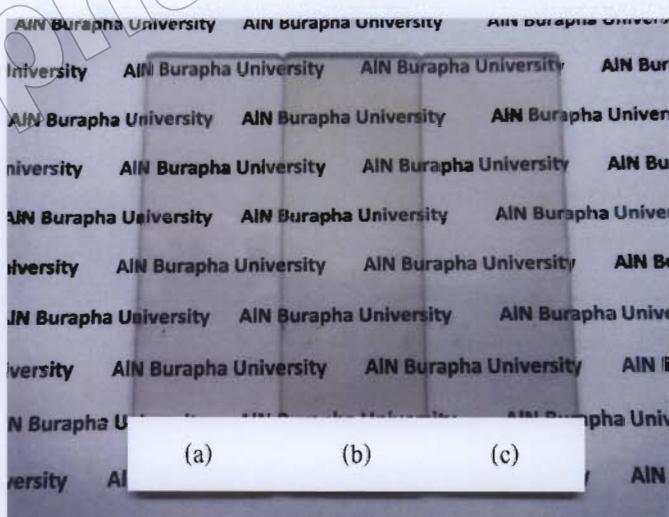
บทนี้กล่าวถึงข้อมูลจากการทดลองตามแนวทางการศึกษาในบทที่ 3 เรื่องจากผลของอัตราไหเลแก๊สในไตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ ผลของความหนาต่อโครงสร้างของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ผลของอัตราไหเลแก๊สในไตรเจนต่อโครงสร้างฟิล์ม

ส่วนนี้จะเป็นการเสนอผลการศึกษาโครงสร้างของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี แมกนิตรอน สปีตเตอริง โดยกำหนดให้อัตราไหเลแก๊สอาร์กอนคงที่เท่ากับ 15 sccm และแปรค่าอัตราไหเลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 5 sccm, 10 sccm และ 15 sccm ตามลำดับ มีผลดังนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์

ฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบได้จากการแปรค่าอัตราไหเลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามีลักษณะไปเป็นเส้น้ำต้าล่อ่อน ตั้งผ่านแสงได้ดี ดังแสดงในภาพที่ 4-1

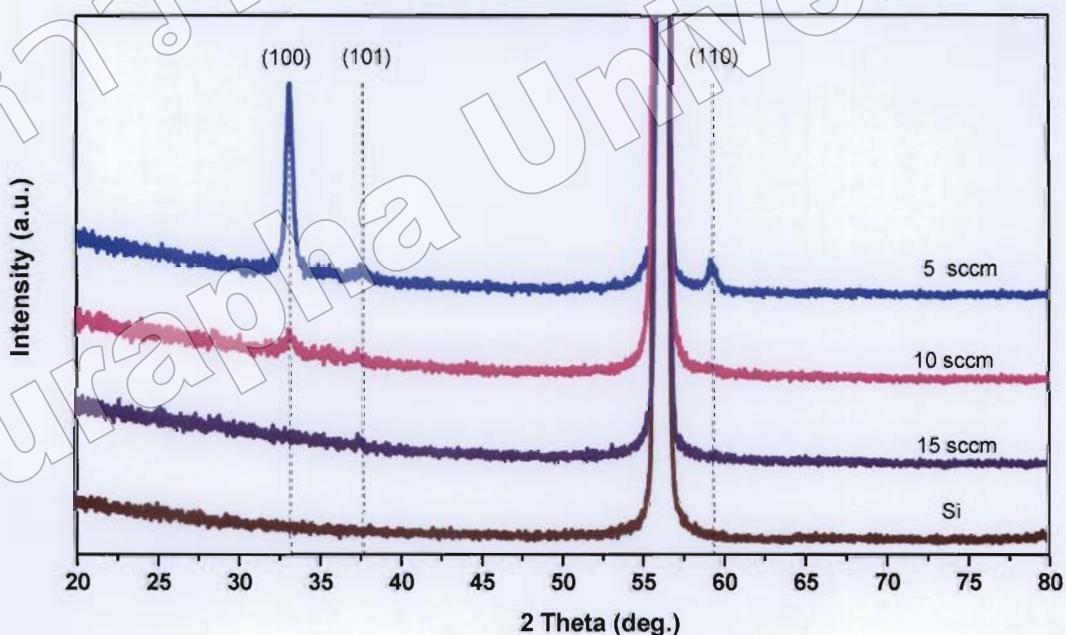


ภาพที่ 4-1 ลักษณะของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนกระจกใส
ที่อัตราไหเลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

(a) 5 sccm, (b) 10 sccm, และ (c) 15 sccm

2. โครงสร้างของฟิล์มบางอุดมเนียมไนไตรด์

ภาพที่ 4-2 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบางอุดมเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบบนแผ่นซิลิโคน โดยแปรค่าอัตราไหเดแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ พบว่าฟิล์มที่เคลือบด้วยอัตราไหเดแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 5 sccm มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุม 33.24° , 37.96° และ 59.39° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบอุดมเนียมไนไตรด์ ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 65-3409 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบhexagonal ที่ระนาบ (100), (101), และ (110) ตามลำดับ โดยที่ระนาบ (100) ฐานพื้นที่มีลักษณะแคบและมีความเข้มของ การเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด ทั้งนี้เมื่ออัตราไหเดแก๊สในไตรเจนเพิ่มเป็น 10 sccm ความเป็นผลึกของฟิล์มลดลง และเปลี่ยนเป็นโครงสร้างแบบสัมฐาน (Amorphous) เมื่ออัตราไหเดแก๊ส ในไตรเจนเท่ากับ 15 sccm พบว่าฟิล์มที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบสัมฐาน โดยที่มุม 56.50° เป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของชาตุซิลิโคน ซึ่งเป็นวัสดุรองรับ



ภาพที่ 4-2 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางอุดมเนียมไนไตรด์ ที่อัตราไหเดแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

ค่าคงที่แลตทิชของฟิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ หาได้จากสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างรากน้ำผลึกในระบบผลึกที่มีโครงสร้างแบบเอกซ์-โกลนอล เนื่องจากพิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ ที่เคลือบได้มีโครงสร้างผลึกแบบเอกซ์-โกลนอล โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางที่ได้พบว่าพิล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจน มีค่าคงที่แลตทิชตรงตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 65-3409 ดังแสดงในตารางที่ 4-1

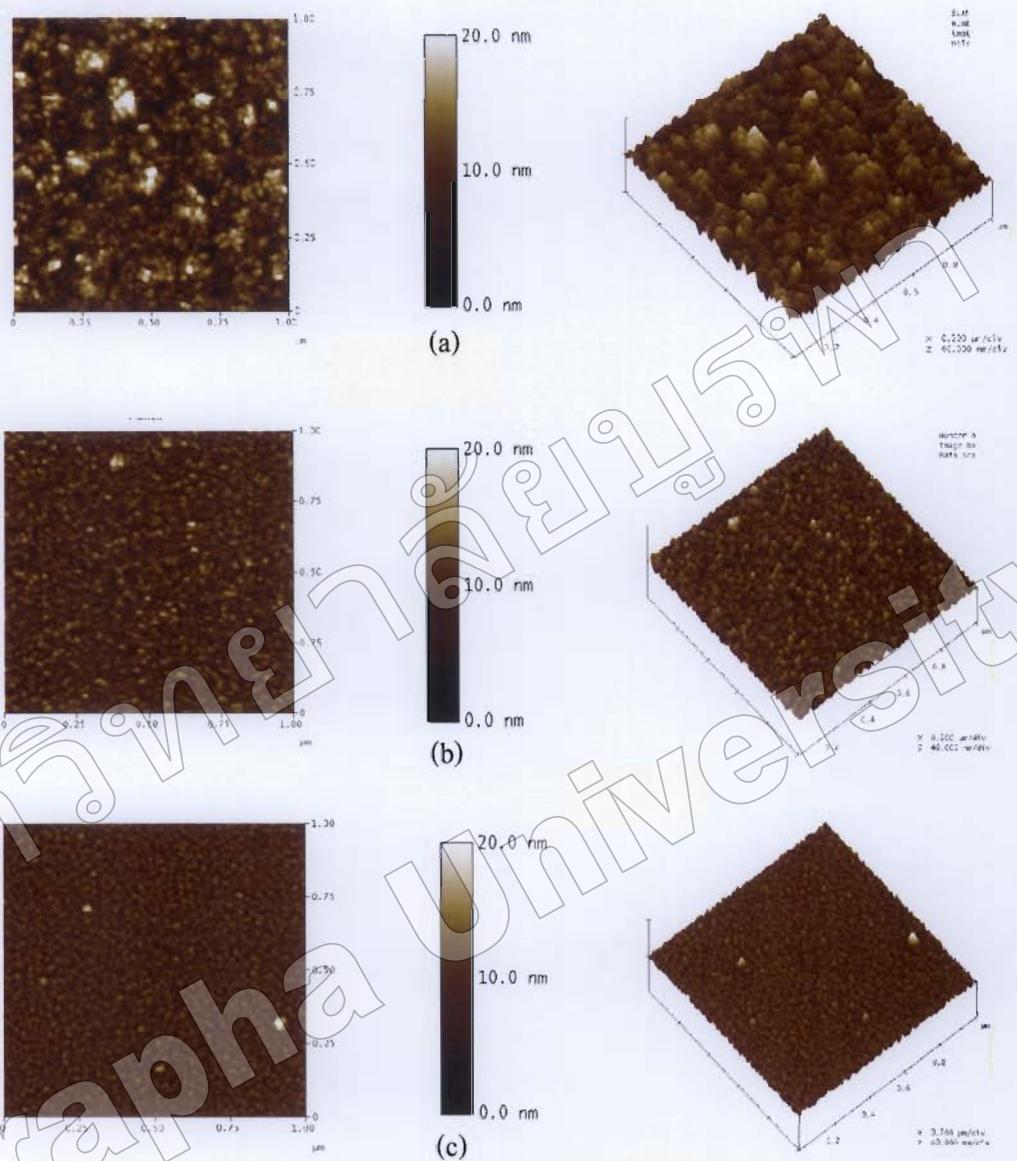
สำหรับขนาดผลึกของพิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ นั้นหาได้จากการของ Seherrer โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของพิล์มบางที่ได้พบว่าพิล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าอัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 5 sccm มีค่าเท่ากับ 34 nm ส่วนที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 10 sccm และ 15 sccm ไม่สามารถคำนวณขนาดผลึกได้เนื่องจากพิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์มีโครงสร้างผลึกแบบอสัมฐาน ดังแสดงในตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 ค่าคงที่แลตทิชของพิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

อัตราไหลแก๊ส ในไตรเจน (sccm)	a (Å)	c (Å)
JCPDS (65-3409)	3.110	4.975
5 sccm	3.112	5.103
10 sccm	-	-
15 sccm	-	-

ตารางที่ 4-2 ขนาดผลึกของพิล์มฟิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ที่อัตราไหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

อัตราไหลแก๊สในไตรเจน (sccm)	ขนาดผลึก (nm)
5	0.245
10	-
15	-



ภาพที่ 4-3 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรค์

ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

- อัตราไหเลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 5 sccm
- อัตราไหเลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 10 sccm
- อัตราไหเลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 15 sccm

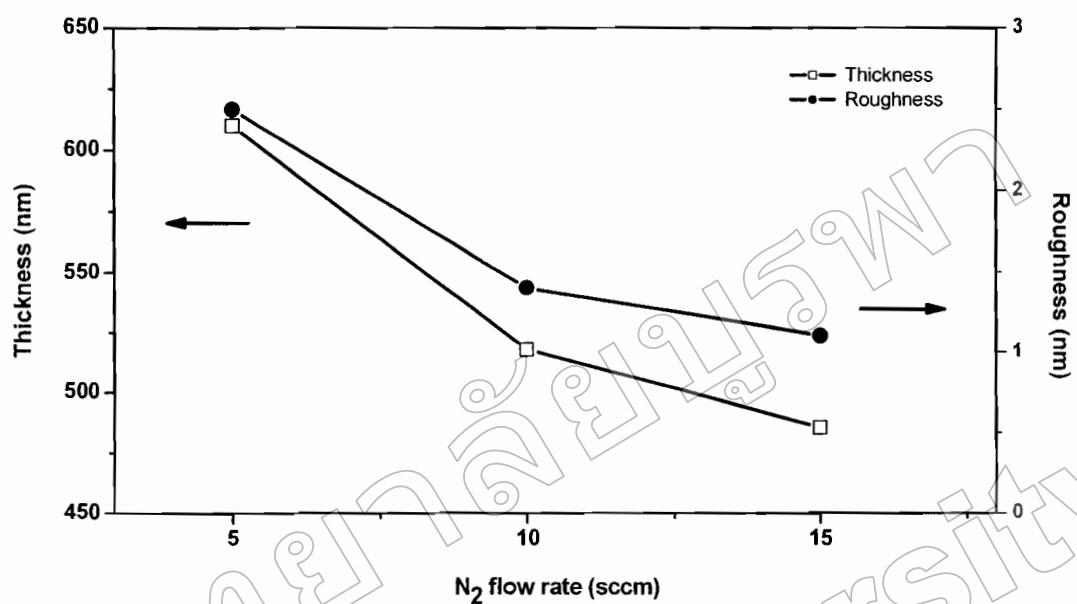
3. ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรค์

ภาพที่ 4-3 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรค์เคลือบที่อัตราไหหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ จากเทคนิค AFM พบว่าฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรค์ที่เคลือบด้วยอัตราไหหลแก๊สในไตรเจนเท่ากับ 5 sccm เกรนมีลักษณะค่อนข้างแหลมปะปนกันของเกรนขนาดเล็กและใหญ่กระจายทั่วผิวน้ำฟิล์ม โดยมีบางส่วนรวมเป็นกลุ่มค่อนข้างใหญ่ เมื่ออัตราไหหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มเป็น 10 sccm เกรนมีลักษณะแหลมเล็กกระจายทั่วผิวน้ำฟิล์ม สุดท้ายเมื่ออัตราไหหลแก๊สในไตรเจนมีค่าเท่ากับ 15 sccm เกรนมีลักษณะกลมมนขนาดเล็กใกล้เคียงกันกระจายทั่วผิวน้ำฟิล์ม สำหรับความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรค์ พบว่าเมื่ออัตราไหหลแก๊สในไตรเจนเพิ่มขึ้นจาก 5 sccm เป็น 15 sccm ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนา และความหยาบผิวลดลงจาก 610 nm เป็น 485 nm และ 2.5 nm เป็น 1.1 nm ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4-3

ตารางที่ 4-3 ความหนาและความหยาบผิวของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรค์

ที่อัตราไหหลแก๊สในไตรเจนต่าง ๆ

อัตราไหหลแก๊สในไตรเจน (sccm)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
5	610	2.5
10	518	1.4
15	485	1.1



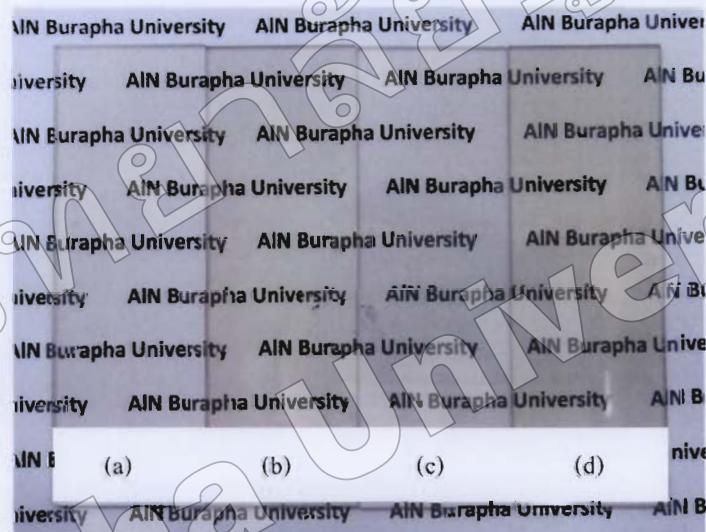
ภาพที่ 4-4 ความหนาและความขรุขระของฟิล์มอลูมิเนียมในไตรค์ที่อัตราไนโตรเจนต่างๆ

ผลของความหนาต่อโครงสร้างฟิล์ม

ส่วนนี้จะเป็นการเสนอผลการศึกษาโครงการสร้างของฟิล์มนางอุ่นนีเยมในไตรค์ที่เคลือบด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สปีดเตอริง โดยแปรค่าความหนาจากเวลาเคลือบท่ากัน 30 min, 60 min, 90 min และ 120 min ตามลำดับ มีผลดังนี้

1. ลักษณะทางกายภาพของฟิล์มนางอุ่นนีเยมในไตรค์

ฟิล์มนางอุ่นนีเยมในไตรค์ที่เคลือบได้จากการแปรค่าความหนาจากเวลาเคลือบต่าง ๆ เมื่อสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่ามีลักษณะไปเป็นสีน้ำตาลอ่อน สำผ่านแสงได้ดี ดังแสดงในภาพที่ 4-5

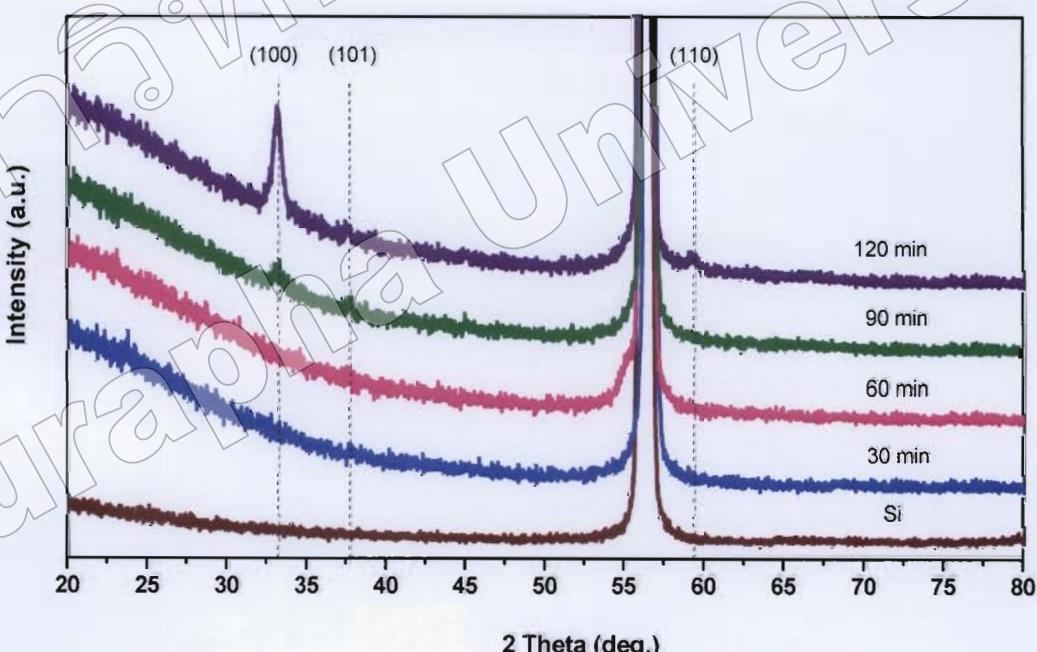


ภาพที่ 4-5 ลักษณะของฟิล์มนางอุ่นนีเยมในไตรค์ที่เคลือบบนกระดาษไดค์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

- (a) 30 min, (b) 60 min, (c) 90 min, และ (d) 120 min

2. โครงสร้างของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์

ภาพที่ 4-6 แสดงรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์จากเทคนิค XRD ของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ ที่เคลือบบนแผ่นซิลิกอน โดยประค่าความหนาจากเวลาเคลือบต่าง ๆ พบร่วมกับฟิล์มที่เคลือบที่เวลาเท่ากัน 30 min และ 60 min มีโครงสร้างผลึกแบบอสัมธาน ส่วนฟิล์มที่เคลือบที่เวลาเท่ากัน 90 min มีโครงสร้างผลึกแบบเซกชั่น โภนอลที่ระนาบ (100) และฟิล์มที่เคลือบที่เวลาเท่ากัน 120 min มีรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ที่มุน 33.24° , 37.96° และ 59.39° ซึ่งตรงกับรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของสารประกอบอุดมเนียมในไตรด์ ตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 65-3409 ที่มีโครงสร้างผลึกแบบเซกชั่น โภนอลที่ระนาบ (100), (101), และ (110) ตามลำดับ โดยที่ระนาบ (100) มีความเข้มของการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์สูงสุด โดยที่มุน 56.5° เป็นรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของชาตุซิลิกอน ซึ่งเป็นวัสดุรองรับ



ภาพที่ 4-6 รูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

ค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ Hädi จากสูตรการคำนวณหาระยะห่างระหว่างรูบบัน พลีกในระบบพลีกแบบเอกซ์ กอนอล เนื่องจากฟิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ที่เคลือบได้มีโครงสร้างพลีกแบบเอกซ์ กอนอล โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าความหนา มีค่าคงที่แล็ตทิชตรงตามมาตรฐาน JCPDS เลขที่ 65-3409 ดังแสดงในตารางที่ 4-4

สำหรับขนาดพลีกของฟิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์นั้นหาได้จากสมการของ Seherrer โดยอาศัยรูปแบบการเลี้ยวเบนรังสีเอกซ์ของฟิล์มบางที่ได้พบว่าฟิล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าความหนาที่เวลาเท่ากับ 30 min, 60 min และ 90 min ไม่สามารถคำนวณขนาดพลีกได้เนื่องจากฟิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์มีโครงสร้างพลีกแบบอสัมธาน ส่วนฟิล์มบางที่เคลือบโดยแปรค่าความหนาที่เวลาเท่ากับ 120 min มีขนาดพลีกเท่ากับ 30 nm ดังแสดงในตารางที่ 4-5

ตารางที่ 4-4 ค่าคงที่แล็ตทิชของฟิล์มบางอลูมิเนียมในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่างๆ

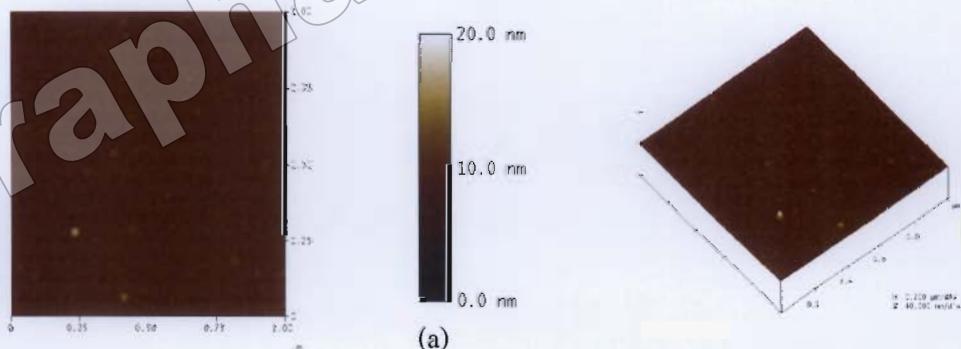
เวลาเคลือบ (min)	a (Å)	c (Å)
JCPDS (65-3409)	3.110	4.975
30	-	-
60	-	-
90	-	-
120 min	3.123	5.029

ตารางที่ 4-5 ขนาดผลึกของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

เวลาเคลือบ (min)	ขนาดผลึก (nm)	
	β (องศา)	Crystallite size (nm)
30 min	-	
60 min	-	
90 min	-	
120 min	0.280	30

3. ความหนาและลักษณะพื้นผิวของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์

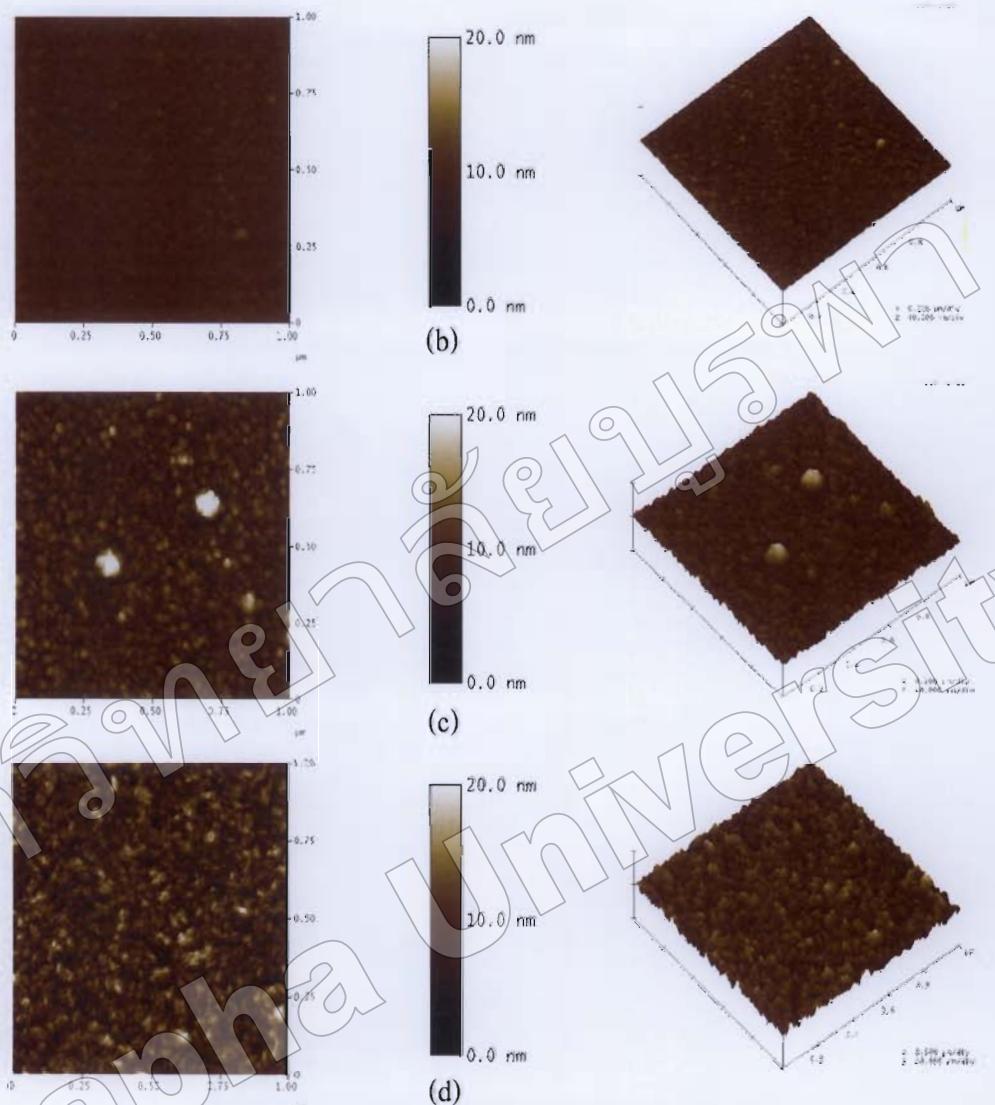
ภาพที่ 4-7 แสดงลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มอุดมเนียมในไตรด์เคลือบที่เปรียบความหนาจากเวลาเคลือบต่าง ๆ จากเทคนิค AFM พบว่าฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบที่เวลาเท่ากับ 30 min และ 60 min ผิวน้ำของฟิล์มมีลักษณะเรียบ ส่วนที่เวลาเคลือบที่เวลา 90 min พบว่าเกرنมีลักษณะเป็นเม็ดกลมมนขนาดเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วพื้นผิวของฟิล์ม และที่เวลาเท่ากับ 120 min พบว่าเกرنมีลักษณะเป็นเม็ดปลายแหลมอยู่ทั่วพื้นผิวของฟิล์ม



ภาพที่ 4-7 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์

ที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

เวลาเคลือบที่เท่ากับ 30 min



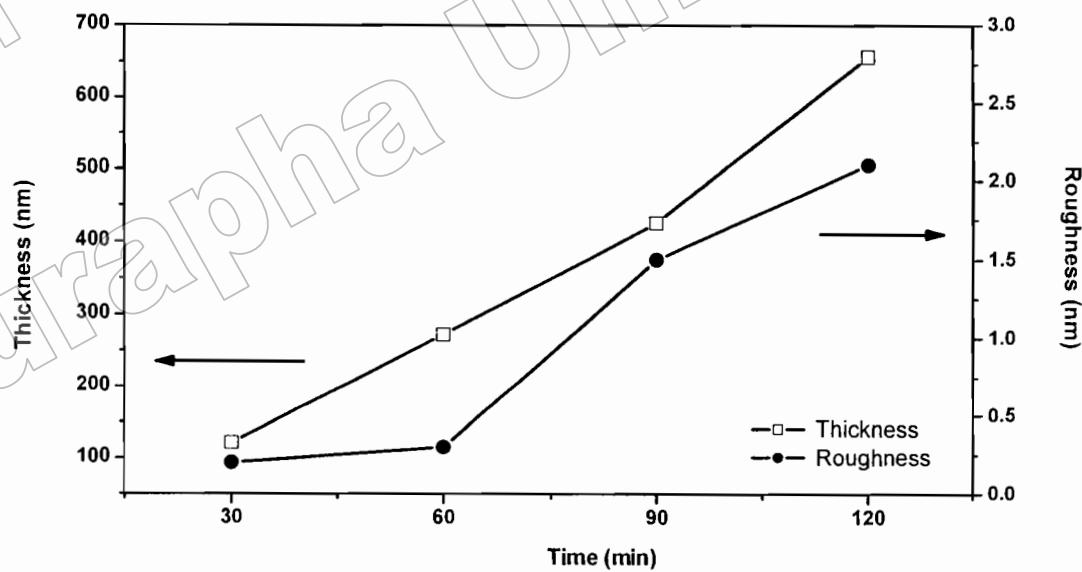
ภาพที่ 4-7 ลักษณะพื้นผิวแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ ของฟิล์มบางอัลูминีียมในไตรดิมที่วิเคราะห์ด้วยเทคนิค AFM

- (b) เวลาเคลือบเท่ากับ 60 min
- (c) เวลาเคลือบเท่ากับ 90 min
- (d) เวลาเคลือบเท่ากับ 120 min

สำหรับความหนา และความหยาบผิวของฟิล์มพบว่าเมื่อเวลาเคลือบเพิ่มขึ้นจาก 30 min เป็น 120 min ฟิล์มที่เคลือบได้มีความหนา และความหยาบผิวเพิ่มขึ้น จาก 121 nm เป็น 656 nm และ 0.2 nm เป็น 2.1 nm ตามลำดับดังแสดงในตารางที่ 4-6

ตารางที่ 4-6 ความหนา และความหยาบผิวของฟิล์มบางอัลูมิเนียม ในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

เวลาเคลือบ (min)	ความหนา (nm)	ความหยาบผิว (nm)
30	121	0.2
60	272	0.3
90	425	1.5
120	656	2.1



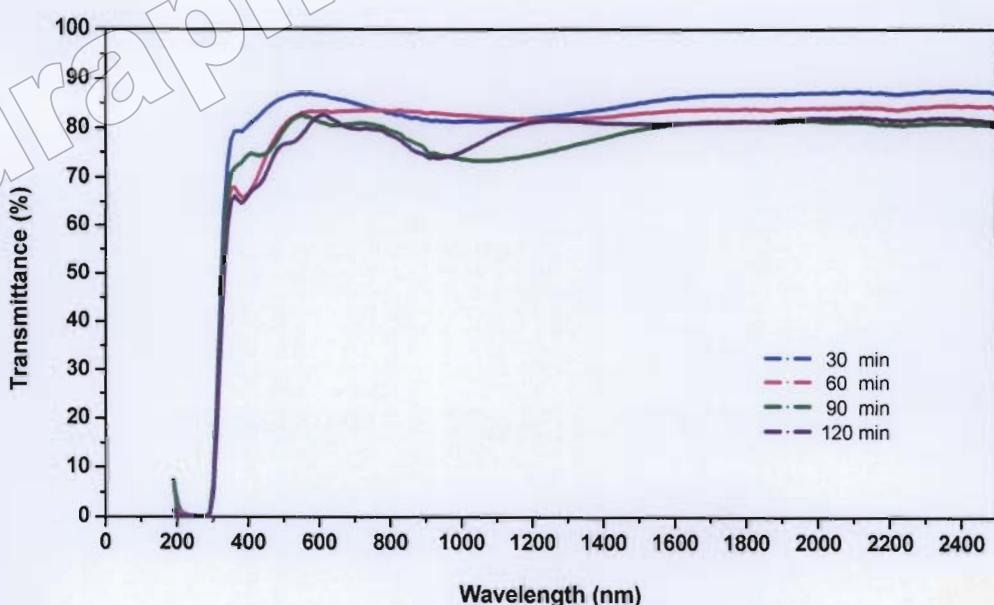
ภาพที่ 4-8 ความหนา และความหยาบผิวของฟิล์มอัลูมิเนียม ในไตรค์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

สมบัติทางแสงและแบบพลังงานของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์

ส่วนนี้จะเป็นการเสนอผลการศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนกระจกไส้โลหะ ด้วยวิธี รีแอคติฟ ดีซี แมกนีตรอน สถาปัตเตอริง โดยกำหนดให้อัตราส่วนแก๊สสารก่อนต่อแก๊สในโตรเจนคงที่เท่ากับ 15 sccm : 5 sccm ระยะห่างระหว่างเป้าสารเคลือบกับวัสดุรองรับเท่ากับ 10 cm และแปรค่าความหนาจากเวลาเคลือบท่ากัน 30 min, 60 min, 90 min และ 120 min ตามลำดับ เพื่อศึกษาผลของความหนาต่อสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ สำหรับสมบัติทางแสงของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่ศึกษาประกอบด้วย ดัชนีหักเหสัมประสิทธิ์การดับสูญ และแบบพลังงาน

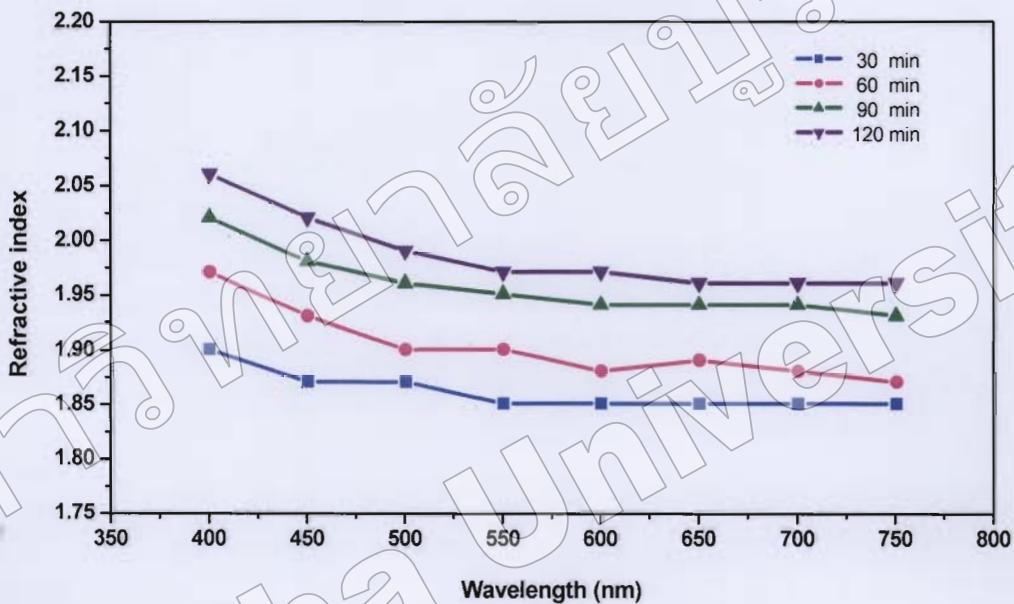
1. ดัชนีหักเหและสัมประสิทธิ์การดับสูญของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์

ฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบโดยแปรค่าความหนาจากเวลาเคลือบในช่วงต่างๆ มีค่าการส่งผ่านแสง ได้ดีทั้งในช่วงตามองเห็นและอินฟราเรดไกล (ความยาวคลื่นในช่วง 300 nm - 2500 nm) โดยมีค่าการส่งผ่านแสงสูงประมาณ 85% ตลอดความยาวคลื่นที่พิจารณา หักเหมาก พิจารณาเบ可想ต์มาร์กการส่งผ่านแสงของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบได้ทั้งหมดพบว่ามีลดลงขณะคลายการกระแสเพื่อมของคลื่นกล่าวคือมีค่าเพิ่มขึ้นและลดลงสัดส่วนกันตลอดความยาวคลื่นแสงที่พิจารณา เนื่องจากการแทรกสอดของแสงผ่านชั้นของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เคลือบบนแผ่นกระจกไส้โลหะนั้นเอง



ภาพที่ 4-9 เปอร์เซ็นต์การส่งผ่านแสงของฟิล์มบางอุดมเนียมในไตรด์ที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

สำหรับค่าดัชนีหักเห (n) และสัมประสิทธิ์การดับสูญ (k) หาได้จากวิธี Swanepoel โดยใช้ข้อมูลจากการสเปกตรัมการส่องผ่านแสงมาคำนวณ พบว่าที่ความยาวคลื่นแสง 600 nm ฟิล์มนางอุ่มเนียมในไตรด์ที่เคลือบโดยแบนเปลี่ยนเวลาในช่วง 30 min ถึง 120 min ดัชนีหักเหมีค่าเพิ่มขึ้นจาก 1.85 เป็น 1.97 (ภาพที่ 4-10) ส่วนค่าสัมประสิทธิ์การดับสูญมีค่าลดลงจาก 0.018 เป็น 0.007 (ภาพที่ 4-11)

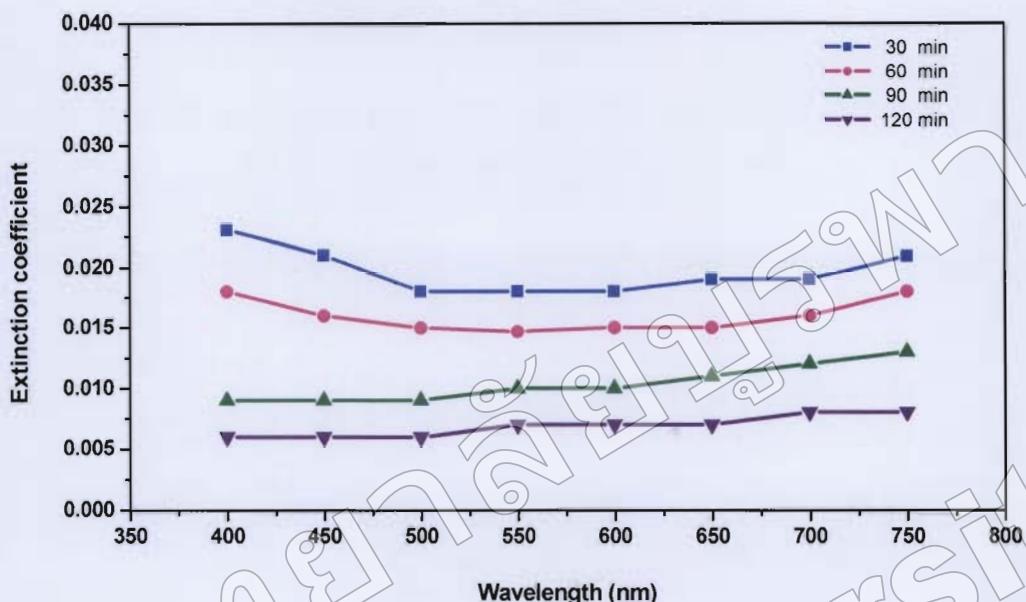


ภาพที่ 4-10 ดัชนีหักเหของฟิล์มนางอุ่มเนียมในไตรด์เคลือบที่เวลาเคลือบต่าง ๆ

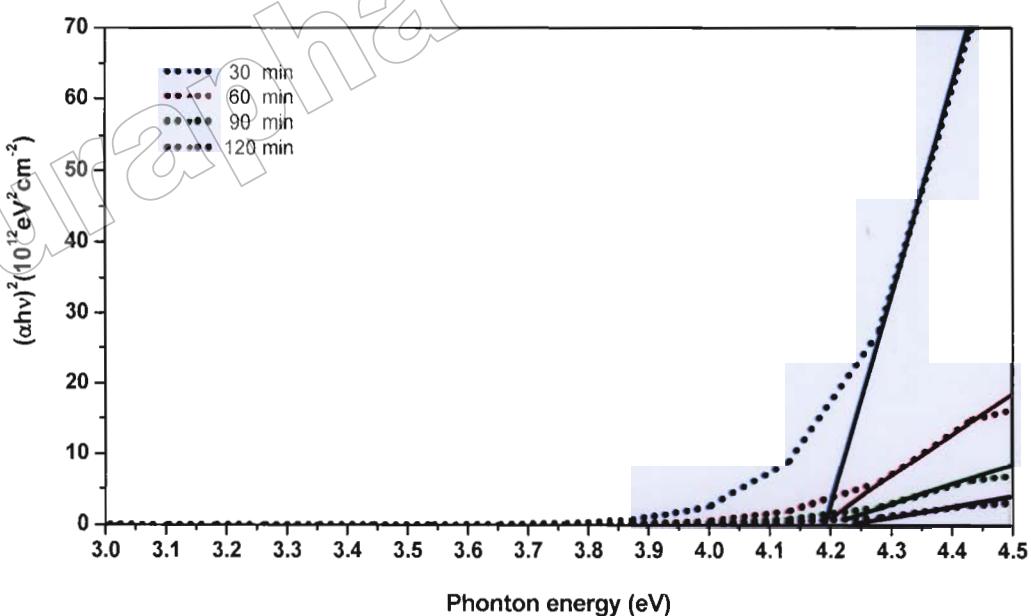
2. แบบพลังงานของฟิล์มนางอุ่มเนียมในไตรด์

ภาพที่ 4-12 แสดงแบบพลังงาน (E_g) ของฟิล์มนางอุ่มเนียมในไตรด์ คำนวณจาก $\alpha_{(\lambda)} = A \sqrt{hv - E_g} / hv$ เมื่อ $p = 2$ (Direct Optical Band Gap) (Henri & Jansen, 1991)

พบว่าแบบพลังงานของฟิล์มนางอุ่มเนียมในไตรด์ ในงานวิจัยนี้มีค่าในช่วง 4.19 - 4.24 eV โดยแบบพลังงานมีค่าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามความหนาของฟิล์ม และที่เวลาเคลือบที่ 120 min ฟิล์มนางอุ่มเนียมในไตรด์มีแบบพลังงานเท่ากับ 4.24 eV



ภาพที่ 4-11 สัมประสิทธิ์การดับสัญญาณฟิล์มนางอลูมิเนียม ในไตรค์ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ



ภาพที่ 4-12 แบบพลังงานของฟิล์มนางอลูมิเนียม ในไตรค์ที่เวลาเคลื่อนต่าง ๆ